







	<h2>SI7491DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7491DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7491DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7491DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 11A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7491DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7491DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7491DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7491DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7491DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7495DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 13A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7491DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7495DP Vishay Precision Group SI7495DP VISHAY</p>
 <p>SI7491DP SI SI7491DP SI</p>	 <p>SI7495DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 13A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7489DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7491DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

SI7465DP-T1-GE3	SI7470DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3	SI7478DP
SI7478DP-T1-E3	SI7478DP-T1-E3	SI7478DP-T1-GE3	SI7478DP-T1-GE3	SI7483ADP
SI7483ADP-T1-E3	SI7483ADP-T1-E3	SI7483ADP-T1-GE3	SI7483ADP-T1-GE3	SI7483DP-T1
SI7483DP-T1-E3	SI7483DP-T1-GE3	SI7485DP-T1-E3	SI7485DP-T1-E3	SI7485DP-T1-GE3
SI7485DP-T1-GE3	SI7489DP	SI7489DP-T1-GE3	SI7489DP-T1-GE3	SI7491DP
SI7491DP-T1-GE3	SI7501DN-T1-E3	SI7501DN-T1-E3	SI7540ADP-T1-GE3	SI7540ADP-T1-GE3
SI7540DP-T1-E3	SI7540DP-T1-E3	SI7540DP-T1-GE3	SI7540DP-T1-GE3	SI7606DN-T1-E3
SI7606DN-T1-GE3	SI7611DN-T1-GE3	SI7611DN-T1-GE3	SI7613DN-T1-GE3	SI7613DN-T1-GE3
SI7615ADN-T1-GE3	SI7615ADN-T1-GE3	SI7615DN	SI7615DN-T1-E3	SI7615DN-T1-GE3
SI7615DN-T1-GE3	SI7617DN-T1-GE3	SI7617DN-T1-GE3	SI7619DN-T1-GE3	SI7619DN-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited